

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第4099324号
(P4099324)

(45) 発行日 平成20年6月11日 (2008. 6. 11)

(24) 登録日 平成20年3月21日 (2008. 3. 21)

(51) Int. Cl.

F I

G O 2 F 1/1343 (2006. 01)

G O 2 F 1/1343

G O 2 F 1/1335 (2006. 01)

G O 2 F 1/1335 5 0 0

請求項の数 5 (全 12 頁)

(21) 出願番号 特願2001-279821 (P2001-279821)
 (22) 出願日 平成13年9月14日 (2001. 9. 14)
 (65) 公開番号 特開2002-221732 (P2002-221732A)
 (43) 公開日 平成14年8月9日 (2002. 8. 9)
 審査請求日 平成16年6月18日 (2004. 6. 18)
 (31) 優先権主張番号 特願2000-359227 (P2000-359227)
 (32) 優先日 平成12年11月27日 (2000. 11. 27)
 (33) 優先権主張国 日本国 (JP)

(73) 特許権者 000005049
 シャープ株式会社
 大阪府大阪市阿倍野区長池町2番2号
 (74) 代理人 100062144
 弁理士 青山 稔
 (74) 代理人 100084146
 弁理士 山崎 宏
 (72) 発明者 中島 睦
 大阪府大阪市阿倍野区長池町2番2号
 シャープ株式会社内

審査官 日夏 貴史

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 液晶表示装置

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

液晶層が間に挟まれた一対の基板のうちの一方の基板上に設けられた複数の走査線と、上記基板上に上記走査線に略直交するように設けられた複数の信号線と、上記基板上の上記走査線および上記信号線に囲まれた領域にマトリクス状に夫々配置された複数のスイッチング素子および複数の画素電極と、上記画素電極に対して絶縁膜を挟んで上記基板上の略表示画面全面に渡って形成された補助容量電極と、上記画素電極に対して上記絶縁膜と上記補助容量電極を挟んで上記基板上の光が透過する開口部を除く略表示画面全面に渡って形成された遮光膜とを備えた液晶表示装置であって、

隣接する上記画素電極間の隙間部分に対応する上記遮光膜の領域と上記補助容量電極の領域が少なくとも部分的に除去されており、

上記遮光膜が部分的に除去された除去部分の幅と上記補助容量電極が部分的に除去された除去部分の幅を、隣接する上記画素電極間の隙間部分の幅よりも大きくしたことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 2】

請求項 1 に記載の液晶表示装置において、

上記走査線と上記信号線および上記スイッチング素子の少なくとも一部に重なるように、上記遮光膜が形成されていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 3】

請求項 1 または 2 に記載の液晶表示装置において、

10

20

上記走査線と上記信号線および上記スイッチング素子の少なくとも一部に重なるように、上記補助容量電極が形成されていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 4】

請求項 1 から 3 までのいずれか 1 つに記載の液晶表示装置において、

上記補助容量電極は、光透過性の材料からなると共に、画素の開口部の少なくとも一部に形成されていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 5】

請求項 1 から 4 までのいずれか 1 つに記載の液晶表示装置において、

上記画素電極が上記走査線および上記信号線の少なくとも一方に重なるように形成されていることを特徴とする液晶表示装置。

10

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

この発明は、アクティブマトリクス型の液晶表示装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

従来より、液晶表示装置としては、マトリクス状に構成された複数の画素電極に対して、複数の走査線、信号線に接続された複数のスイッチング素子により各画素電極の印加電圧を制御し、バックライト等の光源からの光を調整するシャッタとして機能することで画像表示を行うものがある。この液晶表示装置は、CRT(カソード・レイ・チューブ)等の表示装置と比べて、高精細な画像表示ができる特長を有しており、テレビジョン、コンピュータ、情報携帯端末等の幅広い用途に普及している。

20

【0003】

しかし、高精細化が進むと、一方で走査線や信号線および補助容量電極の微細化が困難となるため、光の透過する面積すなわち開口率が減少して明るさが低下するという問題がある。そこで、開口率を増加させるさまざまな改善の取り組みがなされている。

【0004】

そのような開口率を増加させた液晶表示装置として、補助容量を二層の透明導電膜により絶縁膜を挟んだ構造のものがある(特開平 11 - 311805 号公報)。この液晶表示装置の構造では、光の透過する開口部が補助容量の面積に関わらないため、補助容量を十分確保できると同時に開口率を高めることができる。

30

【0005】

図 9 は上記液晶表示装置の構造を示す平面図であり、図 10 は図 9 に示す X - X 線から見た断面図である。以下、上記液晶表示装置の構造について、図 9、図 10 を用いて説明する。

【0006】

図 9、図 10 に示すように、マトリクス基板 51 は、ガラス基板 52 上に複数の走査線 53 および信号線 54 をマトリクス状に配線し、走査線 53 と信号線 54 との交点には TFT(薄膜トランジスタ) 55 を形成している。さらに、画面全体を覆うように平坦膜 56 を形成し、その平坦膜 56 上に、補助容量電極 57、絶縁膜 58、画素電極 59 を順次形成している。これら平坦膜 56、補助容量電極 57、絶縁膜 58 および画素電極 59 は、透明な材料が用いられている。ここで、上記画素電極 59 をスルーホール 60 を介してドレイン電極 61 に接続し、補助容量電極 57 および絶縁膜 58 は、スルーホール 60 付近でパターニング除去されている(図 9 中 62 に示す)。

40

【0007】

また、上記平坦化膜 56 は、画素電極 59 の平坦性を改善することに加えて、信号線 54 と補助容量電極 57 を絶縁できるので、補助容量電極 57 は画面全体に渡って形成することができる。

【0008】

また、上記液晶層 63 を挟んだ対向基板 64 には、ガラス基板 65 上に画素電極 59 周

50

辺からの光モレを防止するため、遮光膜 6 6 と透明導電膜による対向電極 6 7 を形成している。

【 0 0 0 9 】

上記補助容量電極 5 7 に透明導電膜が用いられているので、走査線 5 3 や信号線 5 4 および遮光膜 6 6 で遮光された以外の画素電極 5 9 が画素の開口部となると共に、画素電極 5 9 とほぼ同様の面積で補助容量を形成している。

【 0 0 1 0 】

【発明が解決しようとする課題】

ところで、上記液晶表示装置では、十分な補助容量と高い開口率を得ることを目的としているが、一方で画素電極周辺部で液晶の配向乱れが生じて表示品位を著しく劣化させる原因にもなっている。

10

【 0 0 1 1 】

図 1 1 は図 9 に示す XI - XI 線から見た断面図であり、以下、上記表示品位を著しく劣化させる原因について図 1 1 を用いて説明する。

【 0 0 1 2 】

図 1 1 に示すように、マトリクス基板 5 1 および対向基板 6 4 の内側には配向膜(図示しない)が塗布され、ラビング処理等を実施することによって、液晶層 6 3 の液晶分子 6 8 は、ある一定の傾斜角度を有してほぼ平行に配向されている。この傾斜角度はプレチルト角 6 9 と呼ばれ、ラビング処理の進行方向 7 0 側が持ち上がるように生じる。

【 0 0 1 3 】

20

上記液晶表示装置において、画像表示するとき、画素電極 5 9 には映像信号に応じた電圧が印加される。そして、液晶分子 6 8 はプレチルト角 6 9 に応じて電気力線の沿う方向に配向し、配向状態の変化に応じた光学変調がなされる。上記補助容量電極 5 7 には、対向電極 6 7 との間に電位差が生じないように、対向電極 6 7 と同様の電圧が印加されている。

【 0 0 1 4 】

このとき、画素電極 5 9 の中心部 7 1 では、ほぼ垂直に電界が形成されるので、液晶分子 6 8 の配向が一様に変化する。しかしながら、画素電極 5 9 の周辺近傍 7 2 では、画素電極 5 9 から補助容量電極 5 7 に対して強い横電界(図 1 1 中に電界方向を破線で示す)が生じるため、この電界の影響で液晶分子 6 8 の配向が乱れてしまう。顕著な場合は、電圧印可時における画素電極の周辺近傍 7 2 の液晶分子 6 8 の回転方向が、画素電極 5 9 の中心部 7 1 での回転方向と反対になるリバースチルトと呼ばれる現象が発生する(図 1 1 中に推定される液晶分子の回転方向を矢印で示す)。このような場合、配向乱れが画素電極 5 9 の内側まで及ぶため、画素電極 5 9 の周辺で光モレ等が生じて、画像の表示品位が著しく低下するという問題がある。

30

【 0 0 1 5 】

このような配向乱れの影響を防止するには、例えば走査線、信号線および遮光膜の幅を広げるなどして、配向乱れの生じる領域を遮光すればよいが、開口率を減少させる結果となり開口率を増加させる効果が十分得られない。また、補助容量絶縁膜の厚さを増加させれば、補助容量電極からの電界の影響を低減させることができるが、補助容量が減少してしまうので、補助容量が十分に確保することができない。

40

【 0 0 1 6 】

そこで、この発明の目的は、高精細化しても表示品位の劣化を引き起こすことなく、十分な補助容量と高い開口率が得られる液晶表示装置を提供することにある。

【 0 0 1 7 】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するため、第 1 の発明の液晶表示装置は、液晶層が間に挟まれた一対の基板のうちの一方の基板上に設けられた複数の走査線と、上記基板上に上記走査線に略直交するように設けられた複数の信号線と、上記基板上の上記走査線および上記信号線に囲まれた領域にマトリクス状に夫々配置された複数のスイッチング素子および複数の画素電

50

極と、上記画素電極に対して上記絶縁膜と上記補助容量電極を挟んで上記基板上の光が透過する開口部を除く略表示画面全面に渡って形成された遮光膜とを備えた液晶表示装置であって、隣接する上記画素電極間の隙間部分に対応する上記遮光膜の領域と上記補助容量電極の領域が少なくとも部分的に除去されており、上記遮光膜が部分的に除去された除去部分の幅と上記補助容量電極が部分的に除去された除去部分の幅を、隣接する上記画素電極間の隙間部分の幅よりも大きくしたことを特徴としている。

【 0 0 1 8 】

上記第 1 の発明の液晶表示装置によれば、隣接する上記画素電極間の隙間部分に対応する補助容量電極の領域が少なくとも部分的に除去されているので、画素電極から補助容量電極に対して生じる横方向の電界強度を大幅に低減させることが可能となり、画素電極の

10

【 0 0 1 9 】

【 0 0 2 0 】

【 0 0 2 1 】

【 0 0 2 2 】

また、隣接する上記画素電極間の隙間部分に対応する遮光膜の領域が少なくとも部分的に除去されているので、画素電極から遮光膜に対して生じる横方向の電界強度を大幅に低減させることが可能となり、画素電極の周辺近傍で生じる液晶層の配向乱れが改善でき、表示品位の低下を引き起こすことなく、十分な補助容量と高い開口率を両立することができる。

20

また、上記補助容量電極の除去部分の幅を上記画素電極間の隙間部分の幅より大きくすることによって、補助容量電極を画素電極より内側に形成することができるので、上記液晶層における補助容量電極からの電界成分を画素電極で効果的にシールドし、表示品位の低下を防止できる。

さらに、上記遮光膜の除去部分の幅を上記画素電極間の隙間部分の幅より大きくすることによって、遮光膜を画素電極より内側に形成することができるので、上記液晶層における遮光膜からの電界成分を画素電極で効果的にシールドし、表示品位の低下を防止できる

。

【 0 0 2 3 】

30

また、一実施形態の液晶表示装置は、上記走査線と上記信号線および上記スイッチング素子の少なくとも一部に重なるように、上記遮光膜が形成されていることを特徴としている。

【 0 0 2 4 】

上記実施形態の液晶表示装置によれば、上記遮光膜によりスイッチング素子領域を遮光して、スイッチング素子における光リークを低減することができ、さらに、走査線付近および信号線付近から生じる光モレを低減し、コントラストを向上することができるので、強い光が入射するプロジェクション等の用途についても適用可能となる。

【 0 0 2 5 】

また、一実施形態の液晶表示装置は、上記走査線と上記信号線および上記スイッチング素子の少なくとも一部に重なるように、上記補助容量電極が形成されていることを特徴としている。

40

【 0 0 2 6 】

上記実施形態の液晶表示装置によれば、十分な補助容量を形成することが可能となる。

【 0 0 2 7 】

また、一実施形態の液晶表示装置は、上記補助容量電極は、光透過性の材料からなると共に、画素の開口部の少なくとも一部に形成されていることを特徴としている。

【 0 0 2 8 】

上記実施形態の液晶表示装置によれば、十分な補助容量を形成することが可能となる。

【 0 0 2 9 】

50

また、一実施形態の液晶表示装置は、上記画素電極が上記走査線および上記信号線の少なくとも一方に重なるように形成されていることを特徴としている。

【0030】

上記実施形態の液晶表示装置によれば、上記画素電極の周辺近傍における配向乱れがなく、画素電極を走査線、信号線に重ねて画素周辺部の遮光を行うことができるので、画素電極と走査線、信号線の重なり幅が小さくとも、表示品位が低下することなく開口率の増加が可能となる。

【0031】

【0032】

【0033】

10

【0034】

【0035】

【発明の実施の形態】

以下、この発明の液晶表示装置を図示の実施の形態により詳細に説明する。

【0036】

(第1実施形態)

図1はこの発明の第1実施形態の液晶表示装置の平面図であり、図2は図1に示すII-II線から見た断面図である。

【0037】

この第1実施形態の液晶表示装置は、液晶層1を間に挟んだマトリクス基板3と対向基板16とを備えている。上記マトリクス基板3は、ガラス基板2上に、複数の平行な走査線4および複数の平行な信号線5を互いに交差するように配線すると共に、走査線4と信号線5の交点近傍にTFT6を形成している。なお、走査線4および信号線5にAl等の金属材料を用い、TFT6は公知の手段により形成している。

20

【0038】

上記格子状に形成された走査線4、信号線5およびTFT6の上には、基板全体を覆うように平坦化膜7を形成している。上記平坦化膜7は、平坦性の改善や絶縁性、透過性の確保、寄生容量の低減を図るため適切な材料、膜厚が設定されるが、この第1実施形態では、高い平坦性と厚さを得るためにアクリル等の樹脂材料を用いて約2μmの膜厚で形成している。さらに、平坦化膜7の上には、補助容量電極8、絶縁膜9、画素電極10を順次形成している。

30

【0039】

また、上記補助容量電極8と画素電極10の重なり面積と絶縁膜9の材料および厚さにより補助容量が決定される。また、表示ムラやクロストーク等の表示品位の低下を防止するため、補助容量は大きく設定することが好ましいが、絶縁膜9の膜厚が薄いとリーク欠陥が生じやすくなる。そこで、絶縁性、透過性を考慮して適切な材料、膜厚を設定する必要がある。この第1実施形態では、SiO₂等の無機酸化膜やアクリル等の樹脂材料を用いて、膜厚を約0.1μmとしている。また、上記補助容量電極8および画素電極10は、透明導電膜であるITO(Indium-Tin-Oxide: 錫添加酸化インジウム)等を用いている。上記補助容量電極8および絶縁膜9は、スルーホール11でパターニング除去し(図1中12)、このスルーホール11で画素電極10とTFT6のドレイン電極13を接続している。

40

【0040】

さらに、上記画素電極10は、走査線4と信号線5に一部重なるように形成されており、遮光膜を用いずに光の透過する開口部の面積を十分確保できる構造となっている。この第1実施形態では、マトリクス基板3のラビング進入側(マトリクス基板3のラビング処理の進行方向15を図1中に示す)の画素電極10の角に沿った走査線4上および信号線5上で、補助容量電極8をパターニング除去することによりスリット部14を形成している。

【0041】

50

これは、補助容量電極にスリット部を形成しない液晶表示装置について配向乱れを観察したところ、マトリクス基板のラビング進入側の画素電極の角付近に最も配向乱れが生じやすいことが分かり、それを効果的に対策することを目的としている。

【 0 0 4 2 】

上記走査線 4 および信号線 5 の線幅は、開口率を増加させるためにはできるだけ細い方が好ましいが、この第 1 実施形態では、ライン抵抗の増加やパターニング精度の影響を考慮して約 $7\ \mu\text{m}$ としている。また、画素電極 10 間の隙間は約 $5\ \mu\text{m}$ とし、走査線 4 および信号線 5 と画素電極 10 の重なり幅は約 $1\ \mu\text{m}$ としている。補助容量電極 8 のスリット部 14 の幅については、画素電極 10 間の隙間より大きくなるように約 $6\ \mu\text{m}$ 幅としている。また、液晶層 1 の厚さを約 $4\ \mu\text{m}$ としている。

10

【 0 0 4 3 】

一方、上記対向基板 16 には、ガラス基板 17 に透明導電膜による対向電極 18 が形成されている。

【 0 0 4 4 】

次に、この第 1 実施形態における液晶層の電界について説明する。図 3 は図 1 の III - I II 線から見た断面を示している。

【 0 0 4 5 】

図 3 に示すように、上記画素電極 10 の中心部 19 では、画素電極 10 と対向電極 18 に対して垂直方向に電界が形成されている(図 3 中に電界方向を破線で示す)。一方、上記画素電極 10 の端部 20 では電界の歪みが生じているものの、この第 1 実施形態では、補助容量電極 8 が画素電極 10 間の隙間部分で除去されているので、従来技術と比べ補助容量電極 8 から画素電極 10 に対する横方向の電界強度が大幅に低減される。この結果、液晶層 1 の液晶分子 21 は、画素電極 10 の中心部 19 および画素電極 10 の端部 20 のどちらにおいても、配向乱れが生じることがなかった(図 3 中に推定される液晶分子の回転方向を矢印で示す)。

20

【 0 0 4 6 】

なお、横方向の電界強度を低減させるには、画素電極 10 間の隙間に対して補助容量電極 8 のスリット幅を広くし、補助容量電極 8 の端が画素電極周辺より内側に形成する方が好ましいが、補助容量電極 8 のスリット幅を広げすぎると、画素電極 10 と補助容量電極 8 の重なり面積が小さくなって補助容量が低下するため、液晶の配向乱れを防止できる範囲内で補助容量電極のスリット幅の最適化を行うとよい。ただし、画素電極 10 間の隙間に対して補助容量電極 8 のスリット幅が狭い場合でも電界強度の低減効果は得られる。

30

【 0 0 4 7 】

また、走査線からの電界の影響をできるだけ避けるためには、平坦化膜の膜厚は厚い方が好ましく、補助容量を損なわず液晶の配向乱れを防止できる範囲内で最適化を行うとよい。

【 0 0 4 8 】

(第 2 実施形態)

図 4 は、この発明の第 2 実施形態の液晶表示装置の平面図である。断面図は第 1 実施形態と同様である。この第 2 実施形態の液晶表示装置では、補助容量電極のスリット部 22 を走査線 4 上に沿って形成している点が第 1 実施形態の液晶表示装置と異なり、同一構成部は同一参照番号を付して説明を省略する。

40

【 0 0 4 9 】

一般に液晶表示装置は、交流駆動させるので、信号電圧極性についてさまざまな駆動方法があり、この第 2 実施形態では、走査線毎に信号電圧極性を反転させる駆動方法を行っている。この駆動方法による液晶表示装置の画素電極周辺の配向乱れの発生について観察した結果、特に走査線側の画素電極周辺で配向乱れが顕著に現れることが分かり、このような駆動方法に対しては、スリット部 22 を走査線 4 上に沿って形成する構造が特に効果的であった。

【 0 0 5 0 】

50

このように、配向乱れの発生しやすい位置が、マトリクス基板のラビング方向や映像信号電圧極性の駆動方法によって異なるので、最も発生しやすい領域に補助容量電極のスリット部を形成することが重要である。例えば、信号線毎に信号電圧の極性を反転させる駆動方法では、信号線に沿った画素電極周辺部に配向乱れが生じやすく、このような場合は、信号線付近の補助容量電極もパターニング除去するなど、最も配向乱れの発生しやすい領域に補助容量電極のスリットを形成することが重要である。

【 0 0 5 1 】

ただし、補助容量電極にスリット部を設けることで、画素電極の周辺近傍の横方向の電界を軽減できるので、ラビング方向や駆動方向に対するスリット部の配置や形状は、上記第 2 実施形態の液晶表示装置と異なってもよい。

10

【 0 0 5 2 】

(第 3 実施形態)

図 5 はこの発明の第 3 実施形態の液晶表示装置の平面図であり、図 6 は図 5 に示す VI - VI 線から見た断面図である。

【 0 0 5 3 】

図 5 , 図 6 に示すように、液晶層 3 1 を間に挟んだマトリクス基板 3 3 と対向基板 4 6 とを備えている。上記マトリクス基板 3 3 は、ガラス基板 3 2 上に、複数の平行な走査線 3 4 および複数の平行な信号線 3 5 を互いに交差するように配線すると共に、走査線 3 4 と信号線 3 5 の交点近傍に T F T 3 6 を形成している。

【 0 0 5 4 】

20

上記格子状に形成された走査線 3 4 , 信号線 3 5 および T F T 3 6 の上には、基板全体を覆うように平坦化膜 3 7 を形成している。さらに、平坦化膜 3 7 の上には、遮光膜 3 8 、絶縁膜 3 9 、画素電極 4 0 を順次形成している。

【 0 0 5 5 】

この第 3 実施形態の液晶表示装置では、遮光性の材料で形成している遮光膜 3 8 が補助容量電極を兼用している点が異なる。上記遮光膜 3 8 は A l 等の金属材料を用いている。このような構造においても、補助容量電極専用の配線のための微細化が不要となり、高精細化に適している。

【 0 0 5 6 】

上記遮光膜 3 8 と画素電極 4 0 の重なり面積と絶縁膜 3 9 の材料および厚さにより補助容量が決定される。また、上記画素電極 4 0 は、透明導電膜である I T O 等を用いている。

30

【 0 0 5 7 】

また、上記遮光膜 3 8 は、画素電極 4 0 および T F T 3 6 より内側でパターニング除去され、その光が透過する部分が開口部 4 9 となる。上記遮光膜 3 8 により T F T 3 6 領域を遮光し、T F T 3 6 における光リークを低減することができ、さらに、走査線 3 4 付近および信号線 3 5 付近から生じる光モレを低減し、コントラストを向上することができるので、強い光が入射するプロジェクション等の用途についても適用可能となる。

【 0 0 5 8 】

上記絶縁膜 3 9 および画素電極 4 0 は、スルーホール 4 1 でパターニング除去され(図 5 中 4 2)、このスルーホール 4 1 で画素電極 4 0 と T F T 3 6 のドレイン電極 4 3 を接続している。

40

【 0 0 5 9 】

さらに、上記画素電極 4 0 は、走査線 3 4 と信号線 3 5 に一部重なるように形成されている。この第 3 実施形態では、走査線 3 4 上および信号線 3 5 上でかつ走査線 3 4 と信号線 3 5 の交差領域を除く領域に、遮光膜 3 8 をパターニング除去することにより、画素電極 4 0 の四辺に沿って長形状のスリット部 4 4 を形成している。ただし、各画素毎にスリット部 4 4 は分離されているが、遮光膜 3 8 は全て電氣的に導通している。

【 0 0 6 0 】

一方、上記対向基板 4 6 には、ガラス基板 4 7 に透明導電膜による対向電極 4 8 が形成

50

されている。

【 0 0 6 1 】

この第 3 実施形態では、上記遮光膜 3 8 は、補助容量の形成を兼用することを目的としているが、遮光性のみを目的としたもの、例えばブラックマトリクスでも構わない。また、上記遮光膜の形状は、例えば、走査線領域のみを遮光している場合、信号線領域のみを遮光している場合、T F T 領域のみを遮光している場合等、この実施形態と異なってもよい。

【 0 0 6 2 】

この第 3 実施形態のスリット部 4 4 における液晶の配向乱れに対する効果は、第 1 実施形態および第 2 実施形態と同様である。なお、スリット部の形状については、液晶の配向状態への影響を考慮して適宜変更すればよく、この第 3 実施形態のスリット部と異なってもよい。

【 0 0 6 3 】

(第 4 実施形態)

図 7 はこの発明の第 4 実施形態の液晶表示装置の平面図であり、図 8 は図 7 に示すVIII - VIII 線から見た断面図である。

【 0 0 6 4 】

図 7 , 図 8 に示すように、液晶層 8 1 を間に挟んだマトリクス基板 8 3 と対向基板 9 6 とを備えている。上記マトリクス基板 8 3 は、ガラス基板 8 2 上に、複数の平行な走査線 8 4 および複数の平行な信号線 8 5 を互いに交差するように配線すると共に、走査線 8 4 と信号線 8 5 の交点近傍に T F T 8 6 を形成している。

【 0 0 6 5 】

上記格子状に形成された走査線 8 4 , 信号線 8 5 および T F T 8 6 の上には、基板全体を覆うように平坦化膜 8 7 を形成している。さらに、平坦化膜 8 7 の上には、遮光膜 1 0 1、補助容量電極 8 8、絶縁膜 9 9、画素電極 9 0 を順次形成している。

【 0 0 6 6 】

この第 4 実施形態の液晶表示装置では、遮光性の材料で形成している遮光膜 1 0 1 と透明導電膜で形成されている補助容量電極 9 9 を重ねて形成している点が第 3 実施形態の液晶表示装置と異なる。上記遮光膜 1 0 1 は、画素電極 9 0 および T F T 9 3 より内側でパターンニング除去している。一方、透明導電膜の補助容量電極 8 8 は画素の開口部 1 0 0 を含めて全面的に形成している。

【 0 0 6 7 】

また、上記補助容量電極 8 8 と画素電極 9 0 の重なり面積と絶縁膜 9 9 の材料および厚さにより補助容量が決定される。また、上記補助容量電極 8 8 および画素電極 9 0 は、透明導電膜である I T O 等を用いている。上記補助容量電極 8 8 および絶縁膜 9 9 は、スルーホール 9 1 でパターンニング除去され(図 7 中 9 2)、このスルーホール 9 1 で画素電極 9 0 と T F T 8 6 のドレイン電極 4 3 を接続している。

【 0 0 6 8 】

さらに、上記画素電極 9 0 は、走査線 8 4 と信号線 8 5 に一部重なるように形成されている。この第 4 実施形態では、走査線 8 4 上および信号線 8 5 上でかつ走査線 8 4 と信号線 8 5 の交差領域を除く領域に、遮光膜 1 0 1 および補助容量電極 8 8 をパターンニング除去することにより、画素電極 9 0 の四辺に沿って長方形のスリット部 9 4 を形成している。ただし、各画素毎にスリット部 9 4 は分離されているが、補助容量電極 8 8 は全て電氣的に導通している。

【 0 0 6 9 】

一方、上記対向基板 9 6 には、ガラス基板 9 7 に透明導電膜による対向電極 9 8 が形成されている。

【 0 0 7 0 】

この第 4 実施形態では、補助容量は補助容量電極 9 9 と画素電極 9 0 の重なり面積で決定されるため、開口部 1 0 0 の大きさに関わらず、補助容量を増加することができると同

10

20

30

40

50

時に、必要最小限の遮光領域に遮光膜 101 を形成することができるので、補助容量の増加と開口率の増加を両立することができる。

【0071】

また、遮光膜の形状は、例えば、走査線領域のみを遮光している場合、信号線領域のみを遮光している場合、TFT領域のみを遮光している場合等、この実施形態と異なってもよい。

【0072】

この第4実施形態のスリット部94における液晶の配向乱れに対する効果は、第1実施形態および第2実施形態と同様である。なお、スリット部の形状については液晶の配向状態への影響を考慮して適宜変更すればよく、この第4実施形態のスリット部と異なってもよい。

10

【0073】

上記第1,第2,第3,第4実施形態では、透過型の液晶表示装置について説明したが、反射型等の他の方式の液晶表示装置やスイッチング素子の構造等に関わらず、この発明を適用することができる。

【0074】

【発明の効果】

以上より明らかなように、この発明の液晶表示装置によれば、画素電極周辺の横電界を大幅に低減することが可能となり、液晶層の配向乱れを防止できるため、高精細であっても十分な補助容量と高い開口率が得られると共に、表示品位の良好な液晶表示装置を実現することができる。さらに、強い光が照射される用途例えばプロジェクション用等についても、高コントラストで優れた表示性能が達成できる。

20

【0075】

また、液晶層の配向乱れは、電圧無印加状態における液晶分子の配向膜表面に対する角度いわゆるプレチルト角や配向規制力により発生しやすさが異なることが分かっている。液晶材料や配向膜材料等については、これらの特性が重要な改善課題であるが、これら以外にも電圧保持特性や屈折率、誘電率、弾性定数、転移温度などのさまざまな特性を満たす必要があり、液晶材料や配向膜材料等を開発する上で大きな制約となっている。

【0076】

したがって、この発明を液晶表示装置に適用することで、液晶材料や配向膜材料等の選択の自由度が広がり、例えば応答速度や信頼性など液晶表示装置としての総合的な性能向上を容易に達成することができる。

30

【図面の簡単な説明】

【図1】 図1はこの発明の第1実施形態の液晶表示装置の平面図である。

【図2】 図2は図1に示すII-II線から見た断面図において、第1実施形態の位置関係を図示した断面図である。

【図3】 図3は図1に示すIII-III線から見た断面図である。

【図4】 図4はこの発明の第2実施形態の液晶表示装置の平面図である。

【図5】 図5はこの発明の第3実施形態の液晶表示装置の平面図である。

【図6】 図6は図5に示すVI-VI線から見た断面図である。

40

【図7】 図7はこの発明の第4実施形態の液晶表示装置の平面図である。

【図8】 図8は図7に示すVIII-VIII線から見た断面図である。

【図9】 図9は従来の液晶表示装置の平面図である。

【図10】 図10は図9に示すX-X線から見た断面図である。

【図11】 図11は図9に示すXI-XI線から見た断面図である。

【符号の説明】

1, 31, 63, 81 ... 液晶層、

2, 17, 32, 47, 52, 65, 82, 97 ... ガラス基板、

3, 33, 51, 83 ... マトリクス基板、

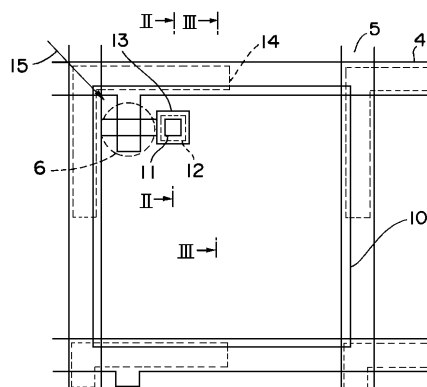
4, 34, 53, 84 ... 走査線、

50

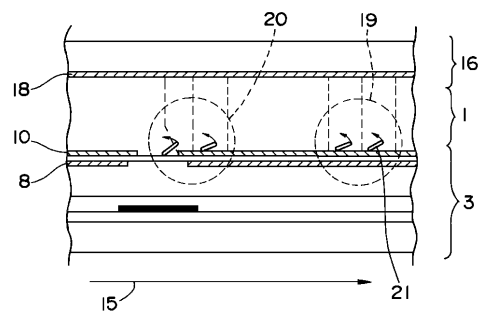
5, 3 5, 5 4, 8 5 ... 信号線、
 6, 3 6, 5 5, 8 6 ... T F T、
 7, 3 7, 5 6, 8 7 ... 平坦化膜、
 8, 5 7, 8 8 ... 補助容量電極、
 9, 3 9, 5 8, 9 9 ... 絶縁膜、
 10, 4 0, 5 9, 9 0 ... 画素電極、
 11, 4 1, 6 0, 9 1 ... スルーホール、
 12, 4 2, 6 2, 9 2 ... スルーホール付近パターンニング除去部分、
 13, 4 3, 6 1, 9 3 ... ドレイン電極、
 14, 4 4, 2 2, 9 4 ... スリット部、
 15, 7 0 ... ラビング処理の進行方向、
 16, 4 6, 6 4, 9 6 ... 対向基板、
 18, 4 8, 6 7, 9 8 ... 対向電極、
 19, 7 1 ... 画素電極の中心部、
 20, 7 2 ... 画素電極の周辺近傍、
 21, 6 8 ... 液晶分子、
 38, 6 6, 1 0 1 ... 遮光膜、
 49, 1 0 0 ... 開口部、
 69 ... プレチルト角。

10

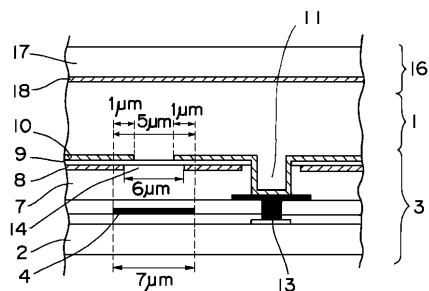
【図 1】



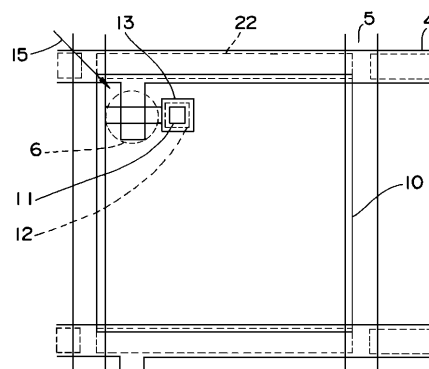
【図 3】



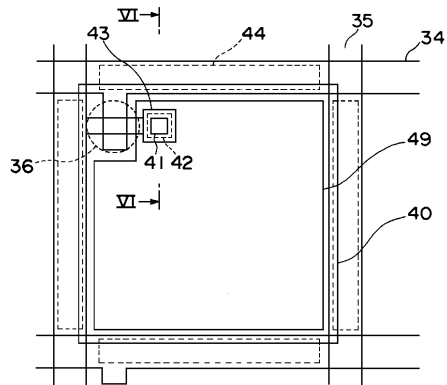
【図 2】



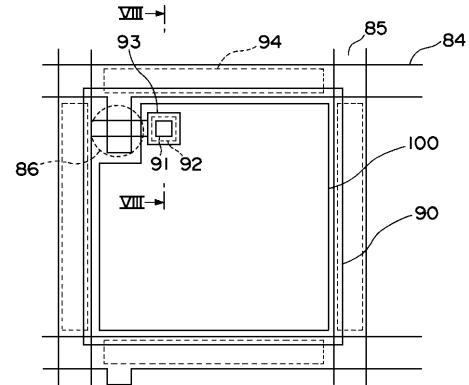
【図 4】



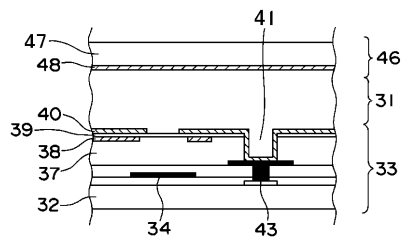
【図 5】



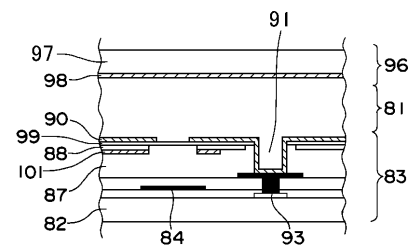
【図 7】



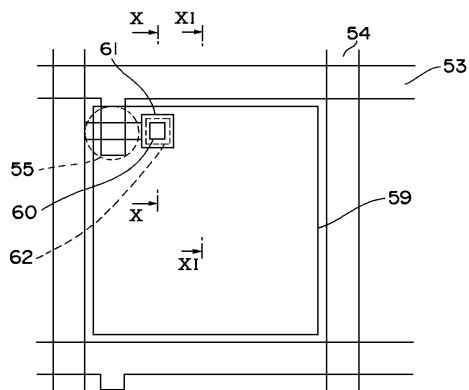
【図 6】



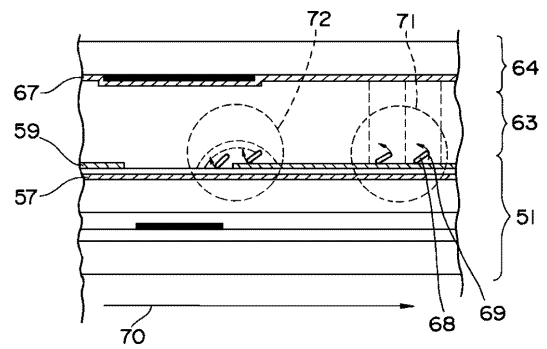
【図 8】



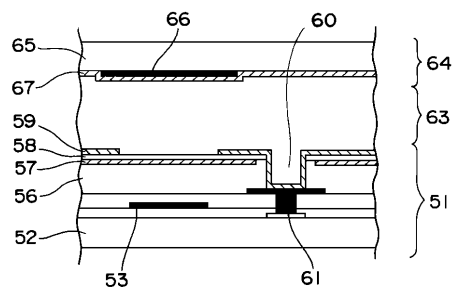
【図 9】



【図 11】



【図 10】



フロントページの続き

- (56)参考文献 特開平04-156511(JP,A)
特開平04-104227(JP,A)
特開2002-055360(JP,A)
特開平10-039336(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

G02F 1/1343

G02F 1/1335 - 1/1337

专利名称(译)	液晶表示装置		
公开(公告)号	JP4099324B2	公开(公告)日	2008-06-11
申请号	JP2001279821	申请日	2001-09-14
[标]申请(专利权)人(译)	夏普株式会社		
申请(专利权)人(译)	夏普公司		
当前申请(专利权)人(译)	夏普公司		
[标]发明人	中島睦		
发明人	中島 睦		
IPC分类号	G02F1/1343 G02F1/1335 G02F1/1333 G02F1/1362 G09F9/30 G09F9/35		
CPC分类号	G02F1/133512 G02F1/136213		
FI分类号	G02F1/1343 G02F1/1335.500 G02F1/1333.505 G09F9/30.338 G09F9/30.349.C G09F9/35		
F-TERM分类号	2H090/HA02 2H090/HB03X 2H090/HB07X 2H090/HD03 2H090/HD07 2H090/JB02 2H090/LA01 2H090/MB01 2H091/FB08 2H091/FD22 2H091/GA02 2H091/LA16 2H092/GA13 2H092/GA15 2H092/GA17 2H092/HA03 2H092/JA24 2H092/JA45 2H092/JB26 2H092/JB35 2H092/JB51 2H092/JB56 2H092/JB63 2H092/JB65 2H092/JB66 2H092/KA21 2H092/KB22 2H092/NA04 2H092/NA07 2H092/PA01 2H190/HA02 2H190/HB03 2H190/HB07 2H190/HD03 2H190/HD07 2H190/JB02 2H190/LA01 2H191/FB14 2H191/FD42 2H191/GA04 2H191/LA21 2H291/FB14 2H291/FD42 2H291/GA04 2H291/LA21 5C094/AA03 5C094/AA05 5C094/AA10 5C094/AA13 5C094/AA31 5C094/AA48 5C094/BA03 5C094/BA43 5C094/CA19 5C094/DA13 5C094/DB04 5C094/EA04 5C094/EA05 5C094/EA07 5C094/EA10 5C094/ED15 5C094/FA01 5C094/FA02 5C094/FB12 5C094/FB15		
代理人(译)	山崎 宏		
优先权	2000359227 2000-11-27 JP		
其他公开文献	JP2002221732A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：提供一种即使在实现高清晰度时也能够获得足够的存储电容和高孔径比而不会导致显示质量劣化的液晶显示装置。在玻璃基板上由扫描线和信号线围绕的区域中以矩阵排列的多个TFT和多个像素电极，以及夹在像素电极和像素电极之间的绝缘膜并且，辅助电容电极8形成在玻璃基板1上的基本显示屏的整个表面上。提供其中部分地去除了与相邻像素电极10之间的间隙对应的辅助电容电极8的区域的狭缝部分14。此外，像素电极10形成为与扫描线4和信号线重叠。辅助电容电极8的狭缝部分14的宽度大于相邻像素电极10之间的间隙部分的宽度。

2】

